

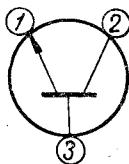
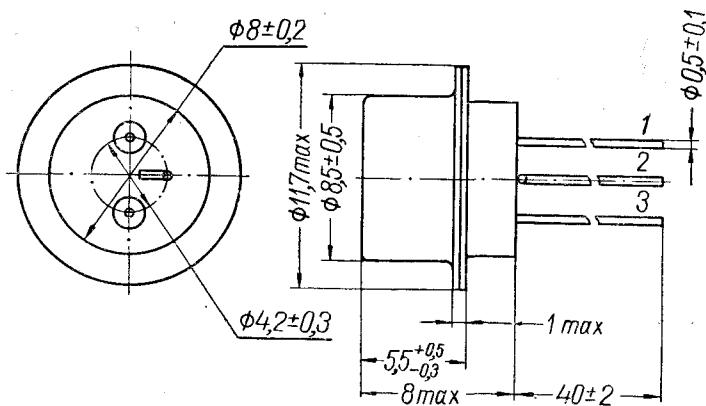
КРЕМНИЕВЫЙ ТРАНЗИСТОР
п-р-п

П307

Оформление — в металлическом герметичном корпусе.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Высота наибольшая (без выводов)	8 мм
Диаметр наибольший	11,7 мм
Вес наибольший	1,46 г



1 — эмиттер
2 — коллектор
3 — база

По техническим условиям ЖК3.365.059 ТУ

Основное назначение — работа в аппаратуре специального назначения.**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ****Обратный ток коллектора ***:при температуре $20 \pm 5^\circ\text{C}$
» » $120 \pm 2^\circ\text{C}$ не более 3 мка
не более 100 мка**Обратный ток эмиттера Δ :**при температуре 20 ± 5 и минус $60 \pm 2^\circ\text{C}$
» » $120 \pm 2^\circ\text{C}$ не более 5 мка
не более 15 мка**Начальный ток коллектора *○:**при температуре 20 ± 5 и минус $60 \pm 2^\circ\text{C}$
» » $120 \pm 2^\circ\text{C}$ не более 20 мка
не более 200 мка**Коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером на низкой частоте □:**при температуре $20 \pm 5^\circ\text{C} \#$
» » $120 \pm 2^\circ\text{C} \diamond$
» » минус $60 \pm 2^\circ\text{C} \#$ 16—50
16—150
10—50**Модуль коэффициента передачи тока на частоте 10 Мгц ▽**не менее 2
не более 70 ом**Входное сопротивление □#****Сопротивление насыщения □ :**при температуре $20 \pm 5^\circ\text{C}$
» » $120 \pm 2^\circ\text{C}$ не более 100 ом
не более 240 ом
не менее 10 000 ч**Долговечность**

* При напряжении коллектора 80 в.

△ При напряжении эмиттера 3 в.

○ При сопротивлении в цепи базы — эмиттер не более 10 ком.

□ При токе эмиттера 10 ма.

При напряжении коллектора 20 в.

◊ При напряжении коллектора 10 в.

▽ При напряжении коллектора 20 в и токе эмиттера 4 ма.

□ В схеме с общим эмиттером при токе коллектора 15 ма и токе базы 3 ма.

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ *

Наибольший ток коллектора и эмиттера

30 ма

Наибольший импульсный ток коллектора □

120 ма

КРЕМНИЕВЫЙ ТРАНЗИСТОР
п-р-п

П307

Наибольшее напряжение:

коллектор — эмиттер Δ 80 в

коллектор — база 80 в

Наибольшее обратное напряжение эмиттер — база 3 в

Наибольшая рассеиваемая мощность O :

при температуре 20° С 250 мвт

» » 60° С 200 мвт

» » 100° С 150 мвт

» » 120° С 100 мвт

* При температуре от минус 60 до плюс 120° С.

□ При скважности не менее 10 и длительности импульса не выше 1 мксек.

△ При сопротивлении в цепи база — эмиттер не выше 10 ком.

Допускается включение сопротивления в цепи базы не более 100 ком при температуре до 60° С, но не превышающее сопротивление в цепи эмиттера.

○ В диапазоне температур от 20 до 100° С наибольшая рассеиваемая мощность при изменении температуры на 1° С снижается на 1,25 мвт, в диапазоне температур от 100 до 120° С — на 2,5 мвт.

УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОТИВ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Температура окружающей среды:

наибольшая плюс 120° С

наименьшая минус 60° С

Наибольшая относительная влажность при температуре 40° С 98%

Давление окружающей среды:

наибольшее 3 ат

наименьшее 5 мм рт. ст.

Наибольшее ускорение при вибрации:

в диапазоне частот 5—2500 гц 15 g

в диапазоне частот 5—5000 гц (кратковременное воздействие) 40 g

Наибольшее ускорение:

линейное 150 g

при многократных ударах 150 g

при одиночных ударах 500 g

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пайка выводов допускается на расстоянии не менее 5 мм, изгиб выводов — на расстоянии 3—5 мм от корпуса, при этом необходимо применять специальные шаблоны.

**П307
П307А
П307Б**

**КРЕМНИЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ
n-p-n**

При эксплуатации в условиях механических ускорений более 2—2,5 g транзисторы необходимо крепить за корпус.

При эксплуатации в условиях изменения температуры окружающей среды в схеме включения транзистора рекомендуется предусматривать температурную стабилизацию.

При эксплуатации транзистора следует учитывать возможность его самовозбуждения как высокочастотного элемента с большим коэффициентом усиления.

Гарантийный срок хранения 12 лет *

* При хранении транзисторов в складских условиях в упаковке поставщика в ЗИПе, а также вмонтированными в аппаратуру. В течение гарантийного срока допускается хранение изделий в полевых условиях:

в) в составе аппаратуры и ЗИП, защищенных от непосредственного воздействия солнечной радиации и влаги, — 3 года;

б) в составе герметизированной аппаратуры и ЗИП в герметизированной укладке, — 6 лет.

П307А

Коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером на низкой частоте:

при температуре $20 \pm 5^\circ\text{C}$ 30—90

» » $120 \pm 2^\circ\text{C}$ 30—270

» » минус $60 \pm 2^\circ\text{C}$ 12—90

Сопротивление насыщения при температуре $20 \pm 5^\circ\text{C}$ не более 130 ом

Примечание. Остальные данные такие же, как у П307.

П307Б

Коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером на низкой частоте:

при температуре $20 \pm 5^\circ\text{C}$ 50—150

» » $120 \pm 2^\circ\text{C}$ 50—450

» » минус $60 \pm 2^\circ\text{C}$ 20—150

Сопротивление насыщения:

при температуре $20 \pm 5^\circ\text{C}$ не более 330 ом

» » $120 \pm 2^\circ\text{C}$ не более 550 ом

Наибольший ток коллектора и эмиттера 15 ма

Примечание. Остальные данные такие же, как у П307.

КРЕМНИЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ
п-р-п

**П307В
П307Г
П308**

П307В

Обратный ток коллектора *:

при температуре $20 \pm 5^\circ\text{C}$	не более 3 мка
» » $120 \pm 2^\circ\text{C}$	не более 100 мка

Начальный ток коллектора *:

при температуре 20 ± 5 и минус $60 \pm 2^\circ\text{C}$	не более 20 мка
» » $120 \pm 2^\circ\text{C}$	не более 200 мка

Коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером на низкой частоте:

при температуре $20 \pm 5^\circ\text{C}$	50—150
» » $120 \pm 2^\circ\text{C}$	50—450
» » минус $60 \pm 2^\circ\text{C}$	20—150

Сопротивление насыщения при температуре $20 \pm 5^\circ\text{C}$

Наибольшее напряжение коллектор — эмиттер и коллектор — база

* При напряжении коллектора 60 в.

Примечание. Остальные данные такие же, как у П307.

П307Г

Сопротивление насыщения:

при температуре $20 \pm 5^\circ\text{C}$	не более 250 ом
» » $120 \pm 2^\circ\text{C}$	не более 550 ом

Наибольший ток коллектора и эмиттера

15 ма

Примечание. Остальные данные такие же, как у П307.

П308

Обратный ток коллектора *:

при температуре $20 \pm 5^\circ\text{C}$	не более 3 мка
» » $120 \pm 2^\circ\text{C}$	не более 100 мка

Начальный ток коллектора *:

при температуре $20 \pm 5^\circ\text{C}$ и минус $60 \pm 2^\circ\text{C}$	не более 20 мка
» » $120 \pm 2^\circ\text{C}$	не более 200 мка

Коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером на низкой частоте:

при температуре $20 \pm 5^\circ\text{C}$	30—90
» » $120 \pm 2^\circ\text{C}$	30—270
» » минус $60 \pm 2^\circ\text{C}$	12—90

**П308
П309**

**КРЕМНИЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ
п-р-п**

Сопротивление насыщения:

при температуре $20 \pm 5^\circ\text{C}$

не более 330 ом

» » $120 \pm 2^\circ\text{C}$

не более 550 ом

Наибольший ток коллектора и эмиттера

15 ма

Наибольшее напряжение коллектор — эмиттер и
коллектор — база

120 в

* При напряжении коллектора 120 в.

Примечание. Остальные данные такие же, как у П307.

П309

Обратный ток коллектора *:

при температуре $20 \pm 5^\circ\text{C}$

не более 3 мка

» » $120 \pm 2^\circ\text{C}$

не более 100 мка

Начальный ток коллектора *:

при температуре 20 ± 5 и минус $60 \pm 2^\circ\text{C}$

не более 20 мка

» » $120 \pm 2^\circ\text{C}$

не более 200 мка

Наибольшее напряжение коллектор — эмиттер и
коллектор — база

120 в

* При напряжении коллектора 120 в.

Примечание. Остальные данные такие же, как у П307.

По техническим условиям ЖК3.365.059 ТУ-1

Основное назначение — работа в аппаратуре широкого применения.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Обратный ток коллектора *:

при температуре $20 \pm 5^\circ\text{C}$
» » $70 \pm 2^\circ\text{C}$

Обратный ток эмиттера Δ

не более 20 мка
не более 100 мка
не более 10 мка

Начальный ток коллектора при температуре $20 \pm 5^\circ\text{C}$ и минус $40 \pm 2^\circ\text{C}$ * \circ

не более 50 мка

Коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером на низкой частоте \square :

при температуре $20 \pm 5^\circ\text{C} \#$
» » $70 \pm 2^\circ\text{C} \diamond$
» » минус $40 \pm 2^\circ\text{C} \#$

16—50

16—150

10—50

не менее 2

не более 70 ом

не более 150 ом

не менее 5000 ч

Модуль коэффициента передачи на частоте $10 \text{ M} \text{гц} \nabla$

Входное сопротивление $\square \#$

Сопротивление насыщения \square

Долговечность

* При напряжении коллектора 80 в.

Δ При напряжении эмиттера 3 в.

\circ При сопротивлении в цепи база—эмиттер не более 10 ком.

\square При токе эмиттера 10 ма.

При напряжении коллектора 20 в.

\diamond При напряжении коллектора 10 в.

∇ При напряжении коллектора 20 в и токе эмиттера 4 ма.

\square В схеме с общим эмиттером при токе коллектора 15 ма и токе базы 3 ма.

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ *

Наибольший ток коллектора и эмиттера

30 ма

Наибольший импульсный ток коллектора

120 ма

Наибольшее напряжение:

коллектор—эмиттер Δ

80 в

коллектор—база

80 в

Наибольшее обратное напряжение эмиттер—база

3 в

Наибольшая рассеиваемая мощность \square :

при температуре 20°C

250 мвт

» » 60°C

200 мвт

* При температуре от минус 40 до плюс 70°C .

Δ При сопротивлении в цепи база—эмиттер 10 ком.

Допускается включение сопротивления в цепи базы не более 100 ком при температуре до 60°C , если сопротивление в цепи эмиттера разно сопротивлению в цепи базы.

\square В диапазоне температур от -40 до 70°C наибольшая рассеиваемая мощность при изменении температуры на 1°C снижается на 1,25 мвт.

УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОТИВ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Температура окружающей среды:

наибольшая	плюс 70° С
наименьшая	минус 40° С
Наибольшая относительная влажность при температуре 40° С	98%
Давление окружающей среды:	
наибольшее	3 атм
наименьшее	203 мм рт. ст.
Наибольшее ускорение:	
при вибрации*	7,5 g
линейное	25 g
при многократных ударах	75 g

* В диапазоне частот 5–2000 зи.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пайка выводов допускается на расстоянии не менее 5 мм, изгиб на расстоянии 3—5 мм от корпуса, при этом необходимо применять специальные шаблоны.

При эксплуатации в условиях механических ускорений транзисторы необходимо крепить на корпусе.

При эксплуатации в условиях изменения температуры окружающей среды в схеме включения транзистора рекомендуется предусматривать температурную стабилизацию.

При эксплуатации транзистора следует учитывать возможность его самовозбуждения как высокочастотного элемента с большим коэффициентом усиления.

* При хранении транзисторов на складах и базах в заводской упаковке или вмонтированных в аппаратуру, в том числе 6 месяцев при нахождении аппаратуры в полевых условиях под чехлом.

П307А

Коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером на низкой частоте:

КРЕМНИЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ
n-p-n

**П307А П307В
П307Б П307Г**

при температуре минус $40 \pm 2^\circ\text{C}$	12—90
Сопротивление насыщения	200 ом

Примечание. Остальные данные такие же, как у П307.

П307Б

Коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером на низкой частоте:

при температуре $20 \pm 5^\circ\text{C}$	50—150
» » $70 \pm 2^\circ\text{C}$	50—450
» » минус $40 \pm 2^\circ\text{C}$	20—150
Сопротивление насыщения	330 ом
Наибольший ток коллектора и эмиттера	15 ма

Примечание. Остальные данные такие же, как у П307.

П307В

Обратный ток коллектора *

при температуре $20 \pm 5^\circ\text{C}$	не более 20 мка
» » $70 \pm 2^\circ\text{C}$	не более 100 мка

Начальный ток коллектора при температуре $20 \pm 5^\circ\text{C}$ и минус $40 \pm 2^\circ\text{C}$ *

не более 50 мка

Коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером на низкой частоте:

при температуре $20 \pm 5^\circ\text{C}$	50—150
» » $70 \pm 2^\circ\text{C}$	50—450
» » минус $40 \pm 2^\circ\text{C}$	20—150

Сопротивление насыщения

250 ом

Наибольшее напряжение коллектор—эмиттер и коллектор—база

60 в

* При напряжении коллектора 60 в.

Примечание. Остальные данные такие же, как у П307.

П307Г

Сопротивление насыщения

не более 250 ом

Наибольший ток коллектора и эмиттера

15 ма

Примечание. Остальные данные такие же, как у П307.

**П308
П309**

**КРЕМНИЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ
п-р-п**

П308

Обратный ток коллектора *:

при температуре $20 \pm 5^\circ\text{C}$
» » $70 \pm 2^\circ\text{C}$

Начальный ток коллектора при температуре 20 ± 5
и минус $40 \pm 2^\circ\text{C}$ *

Коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером на низкой частоте:

при температуре $20 \pm 5^\circ\text{C}$
» » $70 \pm 2^\circ\text{C}$
» » минус $40 \pm 2^\circ\text{C}$

не более 20 мка
не более 100 мка

не более 50 мка

30—90
30—270
12—90

не более 330 ом
15 ма

Сопротивление насыщения
Наибольший ток коллектора и эмиттера
Наибольшее напряжение коллектор—эмиттер и
коллектор—база

120 в

* При напряжении коллектора 120 в.

Примечание. Остальные данные такие же, как у П307.

П309

Обратный ток коллектора *:

при температуре $20 \pm 5^\circ\text{C}$
» » $70 \pm 2^\circ\text{C}$

не более 20 мка
не более 100 мка

Начальный ток коллектора при температуре 20 ± 5
и минус $40 \pm 2^\circ\text{C}$ *

не более 50 мка
не более 200 ом

Сопротивление насыщения
Наибольшее напряжение коллектор—эмиттер и
коллектор—база

120 в

* При напряжении коллектора 120 в.

Примечание. Остальные данные такие же, как у П307.